

課題番号 : F-16-HK-0067  
利用形態 : 技術相談  
利用課題名(日本語) : 平坦な金属電極細線の形成  
Program Title (English) : Formation of flat metal wire with narrow width  
利用者名(日本語) : 大野武雄  
Username (English) : T. Ohno  
所属名(日本語) : 東北大学原子分子材料科学高等研究機構  
Affiliation (English) : WPI-AIMR, Tohoku University

## 1. 概要(Summary)

次世代不揮発性メモリの有力な候補として抵抗変化型メモリが盛んに研究されている。その構造は通常、金属/金属酸化膜/金属のシンプルな構造であるが、下部電極の小さなサイズと良好な平坦性が求められている。そこで微小なサイズと平坦性の課題達成について、北海道大学支援機関に技術相談を行った。

その結果 100 nm 以下の幅を持ちかつ平坦性を有した金属細線の形成手法に関するアドバイスを受け、プロセス検討を行うことにした。

## 2. 実験(Experimental)

技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄

## 4. その他・特記事項(Others)

本課題におきまして松尾保孝先生および大西広氏にご担当いただき、感謝申し上げます。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。